伍、附件

附件一、軍民通用科技合作研究規劃書(由本院執行單位提供併案審查)

一、合作研究內容

(一)合作研究計畫摘要

計畫名稱:先進熱像晶片開發

契約編號:BR1149003

案別:■新建案 □賡續案

中科院材電所固元組/計畫執行負責人:湯相峰/職稱:副研員/電話:357073

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	一 鱼和门 只 只,一 勿旧 于 一 《
評估項目	內容說明
1.計畫目的	1.開發我國先進室溫熱像晶片自製能量。 2. 建立我國先進熱像晶片微機電技術。 3. 取代進口、提高國防自主能力。 4.「協助國內產經」與「建立自主國防」二大目標。
2.計畫目標	114 年度: 完成畫素間距≦12um 測試圖形(testkey)晶片驗證。
3.中科院與合作廠商 分工規劃	廠商: 1.完成畫素間距≦12um 測試圖形(testkey)晶片驗證。 中科院材電所: 1.協助廠商驗證測試畫素間距≦12um 晶片性能。
4.合作廠商投資設施 /設備需求	廠商需具備之設施/設備需求,詳述如下: 1.半導體鍍膜設備 2.四點探針量測儀
5.合作技轉軍用技術 轉化民生應用項目	先進室溫熱像晶片
6.合作研究預期效益	以自製取代進口,可帶動國內產業發展軍民通用高 階室溫熱像自主生產供應鏈。促使廠商轉型,提升 國內光電產業附加價值,帶動電路設計、微機電製 程、真空封裝等相關產業發展。
7.研究分包款建議	需視核定的預算而定,每一案合作研究額度為專案計畫經費 的 10%,須繳交營業稅。

(二)中科院材電所對合作廠商技術輔導及授權項目 <請表列方式填寫>

項目	技術輔導及授權項目	數量	是否涉機密
1	「先進熱像晶片」技術開發	1	□是 ☑否

(三)中科院材電所提供合作廠商之技術智財(含文件)規劃項目 <請表列填寫>

項目	技術智財(含文件)規劃項目	數量	是否涉機密
1	高階熱像晶片核心技術與應用	1	□是 ☑否

2	溫度量測校正方法、電子系統及校正迴歸係數表的 產生方法	1	□是 ☑否
---	--------------------------------	---	-------

(四)中科院材電所必要配合作業項目 <請條綱或表列方式簡要填寫>

項次	作業項目	內容概述
1	技術輔導項目	配合計畫推動時程,適時訪廠、輔導合作廠商,俾利合作 研究案得以如期如質如預算經費完成。
2	技術文件提供	提供本計畫執行所必需之技術文件。

二、成品驗收程序 <請詳實填寫,以表列方式說明產出之產品名稱、時程、驗收方式>

項次	產品名稱及料號	預期交付日	數量	驗收方式
1	畫素間距≦12um 測試圖	114/11/30	2EA	口祖马动处测计
1	形(testkey)晶片	114/11/30	2EA	目視及功能測試

產出之項量 (經測試後歸 中科院所有)	畫素間距≦12um 測試圖形(testkey)晶片
成品研製規格 (請詳述)	高階熱成像電路模組: (1).畫素間距:≦12um (2).響應波段:8-14um
計畫執行時程	114/11/30: 交付畫素間距≦12um 測試圖形(testkey)晶片 2EA。
成品驗收單位	中科院材電所固元組主辦,軍通中心協辦。
程序、檢驗與 驗證方法	如<驗收佐證資料>

三、廠商提案資格審查條件

- (一) 廠商須擁有專業相符的實驗室 <基本要求說明>
 - 1.具備半導體無塵室
 - 2.具備晶片量測實驗室
- (二)廠商本身須僱用專業相關從業員工 <基本要求說明>
 - 1.機械相關從業人員
 - 2.電子相關從業人員
 - 3. 光電材料相關從業人員
- (三) 廠商本身須必備之產品研製設施/設備 <基本要求說明>
 - 1.半導體鍍膜設備
 - 2.四點探針量測儀

四、預期研究成果

1831 17 UMAR					
研究成果項目		預估數			
增加產值	金 額	5,000,000 元			
產出新產品或服務數	件 數	1件			
衍生商品或服務數	件 數	0件			
投入研發費用	金 額	2,000,000 元			
促成投資金額	件數	1 件			
	金 額	10,000,000 元			
增加就業人數	人數	0人			
衍生科專計畫申請	件 數	0件			
1711年们 重甲明	金 額	0元			

<114年度期中/末履約查證廠商應配合事項>

一、期中查證:

1. 期中查證前需備妥經費支用原始憑證(影本)於查證會議中備查: (1)經費支用原始憑證(影本)備查。

二、期末查證:

- 1. 經費支用原始憑證(影本)備妥於查證會議中備查,有關合作研究經費支用原始憑證(影本),結案應繳回材電所(財務組)辦理驗結歸檔存查;有關本計畫合作研究經費動支,須接受本院(財務組)查核,或配合補助機關及審計部需求,得隨時調閱廠商與該計畫相關文件、單據及帳冊等,如有不符該計畫用途經費,本院有權不予核銷,並辦理繳還合作研究經費程序。
- 2. 期末查證前需完成驗收畫素間距≦12um 測試圖形(testkey)晶片 2 EA,繳 交中科院材電所驗證測試。

< 驗收佐證資料>

114年度驗收成品規格及應繳驗資料

- 一、 廠商於期末查證前應繳驗本案研究成果:
 - (一) 畫素間距≦12um 測試圖形(testkey)晶片 2 EA, 繳交中科院材電所驗證測試。

二、本案成品研製規格:

(2). 畫素間距: ≦12um

(2). 響應波段: 8-14um

三、本案成品檢測與驗證方法:

(一)廠商檢附 SEM(掃描式電子顯微鏡)圖或其他量測工具標示畫素間距為≦ 12um。

四、本案規劃建立試認證供應品項:

項目	供應品名稱	料號	圖號	適用計畫
1	畫素間距12um測試圖 形(testkey)晶片	待申請	待申請	法人科專